

半 导 体 学 报

第 8 卷 第 2 期 1987 年 3 月

目 录

- 关于半导体激光器侧向调制相位均匀性的研究……王守武 王仲明 马国荣 (113)
- 异质势垒载流子泄漏对 InGaAsP 半导体激光器阈值温度关系的影响 ……
……郭长志 黄永箴 (122)
- 单边突变 p^+n 结的非耗尽分析……傅春寅 鲁永令 曾树荣 吴恩 (130)
- a-Si(H) 太阳电池最佳结构的一些理论计算……林璇英 杨大同 奚中和 (137)
- MISIS 结构的电特性和 $C(V)$ 研究……陈晖 张继盛 李志坚 (145)
- 新的双层介质的 InP MIS 结构 ……汪正孝 (152)
- 离子注入退火过程中高浓度砷硼再分布扩散的一种新的解析模型……
……汤庭鳌 Carlos Araujo (160)
- 连续模型多弦热平均势计算沟道产额角分布……
……江炳尧 张祖华 周祖尧 杨根庆 邹世昌 (167)
- 关于一维晶体的表面态问题……庞小峰 (175)

研 究 简 报

- 非晶碳化硅薄膜和非晶锗-碳薄膜的拉曼散射研究 ……
……李国华 陶明德 谭辉 曲凤钦 韩英 (182)
- 重掺杂高补偿锗的电导和磁阻……李国华 傅绮英 吕红 王大为 (186)
- P-InP 欧姆接触的 Nd-YAG 激光合金化……王立军 张青月 (190)
- InAs 和 InSb(111) 清洁表面存在 In 岛的实验证据…侯晓远 俞鸣人 王迅 (193)
- InGaAs 的电调制反射谱及其组份分析 ……
……王桂芬 马根源 关德荣 张晓东 张光寅 (196)
- 重掺杂对 Si 能带结构的影响……赵明山 王若桢 (200)
- 掺铟低位错密度的半绝缘砷化镓……林兰英 叶式中 何宏家 曹福年 (204)
- 硅中铂杂质能级的电子辐照效应……龚敏 游志朴 (207)
- 用 CMOS/TTL 兼容工艺实现的模拟乘除器……洪志良 Hans Melchior (210)
- 在 700°C 下液相外延生长的 GaAs、 $Al_xGa_{1-x}As$ 中镁的掺杂特性 ……
……刘宏勋 章蓓 王舒民 虞丽生 王维义 逢明雪 赵阳 (214)
- 高剂量 As 注入单晶 Si 低温加热和高温电子束两步退火性能研究 ……
……卢殿通 张通和 苏颖 高愈尊 (218)

研 究 快 报

- 共腔双稳态半导体激光器的实验研究……李建蒙 彭怀德 王启明 (222)